

N-канальный МОП ПТ КП767В.

Краткий информационный лист

Область применения полевых транзисторов определяется их основными характеристиками:

- Высокие динамические характеристики
- Рабочая температура кристалла 150С
- Низкое сопротивление во включенном состоянии
- Низкая мощность управления
- Высокое коммутируемое напряжение

Типовые применения следующие: высокочастотные импульсные источники питания, системы преобразователей и инверторов для управления скоростью электродвигателей постоянного и переменного тока, высокочастотные генераторы для индукционного нагрева, ультразвуковые генераторы, звуковые усилители, периферийные устройства для компьютеров, оборудование для телекоммуникаций.

Максимально допустимые значения

Условные обозначения	Параметр	Максимум	Ед.изм.
$I_D@T_C=25C$	Постоянный ток стока	18	А
$I_D@T_C=70C$	Постоянный ток стока	11	А
I_{DM}	Импульсный ток стока ⁽¹⁾	72	А
$P_D@T_C=25C$	Рассеиваемая мощность	125	Вт
	Линейное снижение мощности рассеивания от температуры	1.0	Вт/С
V_{GS}	Напряжение затвор-исток	±20	В
E_{AS}	Энергия пробоя одиночным импульсом ⁽²⁾	580	мДж
I_{AR}	Ток лавинного пробоя ⁽¹⁾	18	А
E_{AR}	Энергия пробоя повторяющимися импульсами ⁽¹⁾	13	мДж
dv/dt	Скорость нарастания напряжения на закрытом диоде ⁽³⁾	5.0	В/нс
T_J T_{STG}	Диапазон температур функционирования перехода и хранения прибора	от -55 до +150	С
	Температура пайки при времени менее 10 сек.	300	С

Электрические характеристики @ $T_J = 25C$ (если не указано другое)

Усл. обозначение	Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Режим измерения
$V_{(BR)DSS}$	Максимальное напряжение сток-исток	200	-	-	В	$V_{GS} = 0В,$ $I_D = 250\mu A$
$V_{(BR)DSS}/\Delta T_J$	Температурный коэффициент максимального напряжения	-	0.29	-	В/С	$T = 25C,$ $I_D = 1mA$

$R_{DS(on)}$	Сопротивление сток-исток	-	-	0.18	Ом	$V_{GS} = 10В,$ $I_D = 11А^{(4)}$
$V_{GS(th)}$	Пороговое напряжение на затворе	2.0	-	4.0	В	$V_{DS} = V_{GS},$ $I_D = 250мкА$
g_{fs}	Крутизна характеристики	6.7	-	-	А/В	$V_{DS} = 50В,$ $I_D = 11А^{(4)}$
I_{DSS}	Остаточный ток стока	-	-	25	мкА	$V_{DS} = 200В,$ $V_{GS} = 0В$
		-	-	250		$V_{DS} = 160В,$ $V_{GS} = 0В,$ $T_J = 125С$
I_{GSS}	Ток утечки затвора (прямой)	-	-	100	нА	$V_{GS} = 20В$
	Ток утечки затвора (обратный)	-	-	-100		$V_{GS} = -20В$

Характеристики исток-стока

Усл.обозн.	Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.изм.	Режим изм.
I_S	Постоянный ток истока (через встроенный диод)	-	-	18	А	Условное обозначение полевого транзистора со встроенным диодом
I_{SM}	Импульсный ток истока (через встроенный диод) ⁽¹⁾	-	-	72		
V_{SD}	Прямое напряжение на диоде	-	-	2.0	В	$T_J = 25С,$ $I_S = 18А$ $V_{GS} = 0В^{(4)}$
t_{rr}	Время восстановления	-	300	610	нс	$T_J = 25С,$ $I_F = 18А$
Q_{rr}	Заряд рассасывания	-	3.4	7.1	мкКл	$di/dt = 100А/мкс^{(4)}$

Примечания:

- (1) - частота следования; длительн. импульса ограничена максимальной температурой кристалла
(2) - $V_{DD} = 25В,$ начало $T_J = 25С,$ $L = 2.7мГн,$ $R_G = 25 Ом,$ $I_{AS} = 18А$
(3) - $I_{SD} \div 18А,$ $di/dt \div 150А/мкс,$ $V_{DD} \div V_{(BR)DSS},$ $T_J \div 150С$
(4) - длительн. импульса $\div 300мкс,$ коэффициент заполнения $\div 2\%.$